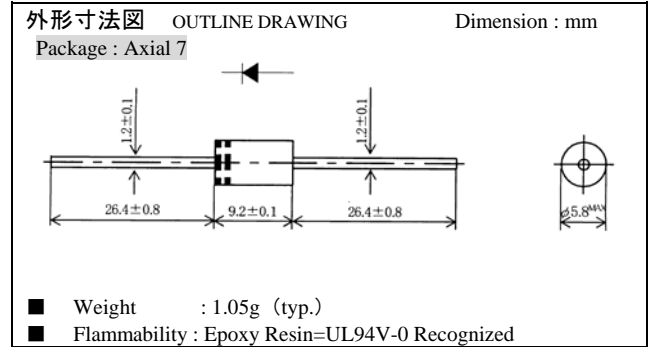


**30GFA20**

構造：拡散型シリコンダイオード (FRD)，リード線型  
 Construction :Diffusion-type Silicon Diode, Axial Lead Type  
 用途：高周波整流用  
 Application : High-Frequency Rectification

**特長**      **Feature**  
 低ノイズ      Low Noise  
 高耐圧      High Voltage  
 高速      High Speed Recovery  
 trr=30ns      trr=30ns



■ 絶対最大定格 (表示無き場合 Ta=25°C) Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C unless otherwise stated)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Rating	単位 Units	
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	—	200	V	
非くり返しピーク逆電圧 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RSM}$	—	220	V	
平均整流電流 Average Rectified Output Current	$I_O$	50Hz 正弦半波通電 抵抗負荷 Half Sine Wave, Resistive Load	Ta=30°C *1	1.55	A
			T1=101°C (T1:Lead Temperature)	3.0	
実効順電流 RMS Forward Current	$I_{F(RMS)}$	—	4.71	A	
サージ順電流 Surge Forward Current	$I_{FSM}$	50Hz 正弦半波 1 サイクル 非繰り返し 50Hz half Sine Wave, 1 cycle, Non-repetitive	60	A	
動作接合温度範囲 Operation Junction Temperature Range	$T_{jw}$	—	-40~+150	°C	
保存温度範囲 Storage Temperature Range	$T_{stg}$	—	-40~+150	°C	

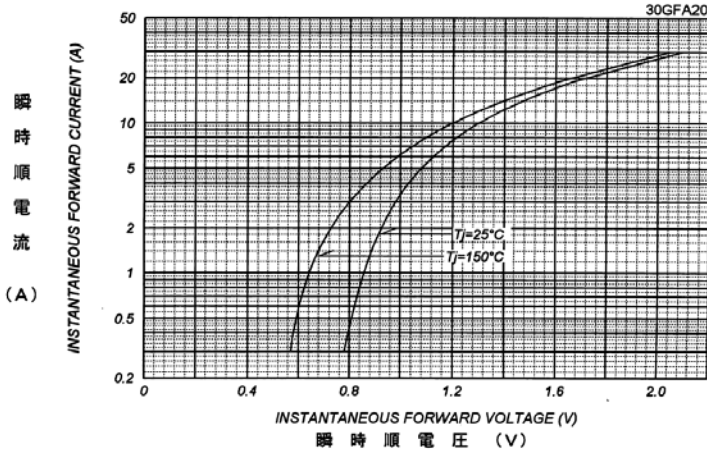
■ 電氣的・熱的特性 Electrical / Thermal Characteristics

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	最小値 min.	代表値 typ.	最大値 max.	単位 Units
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	$I_{RM}$	$V_{RM}=V_{RRM}, T_j=25^\circ C$	—	—	10	μA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	$V_{FM}$	$I_{FM}=3.0A, T_j=25^\circ C$	—	—	0.98	V
逆回復時間 Reverse Recovery Time	$t_{rr}$	$I_{FM}=3.0A, -di/dt=50A/\mu s, T_j=25^\circ C$	—	—	30	ns
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-a)}$	接合部・周囲間 Junction to Ambient *1	—	—	90	°C/W
	$R_{th(j-l)}$	接合部・リード間 Junction to Lead	—	—	15	°C/W

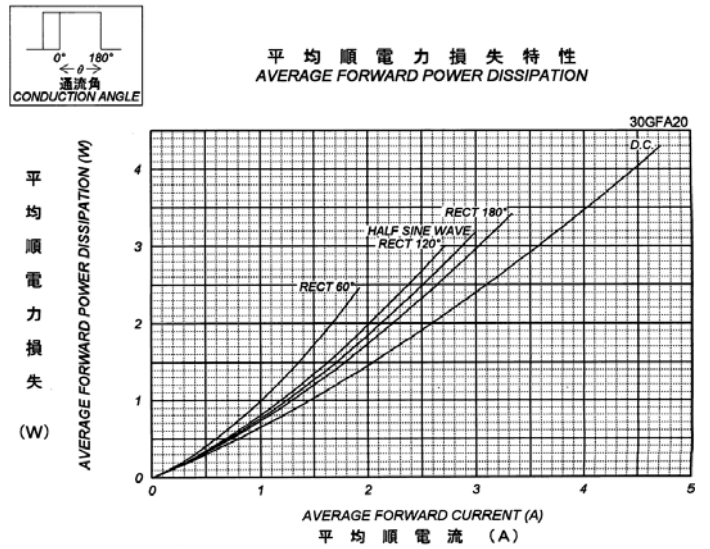
\*1 : 単体フィン無し / Without Fin or P.C. Board

■ 特性図 Characteristics Diagrams

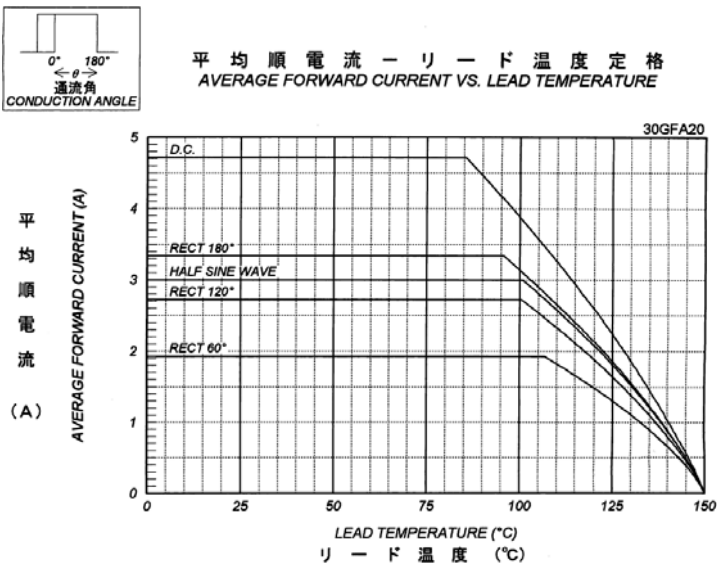
順電圧特性  
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE



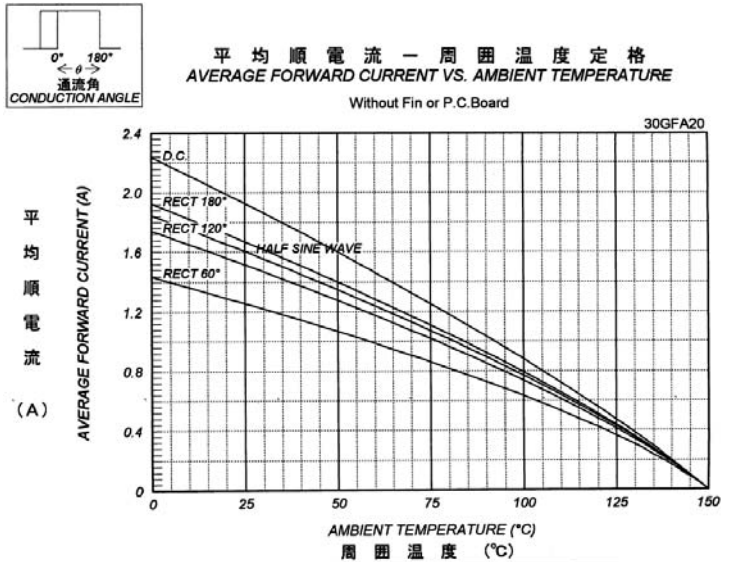
平均順電力損失特性  
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION



平均順電流 - リード温度定格  
AVERAGE FORWARD CURRENT VS. LEAD TEMPERATURE



平均順電流 - 周囲温度定格  
AVERAGE FORWARD CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE



サージ順電流定格  
SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, No Load

